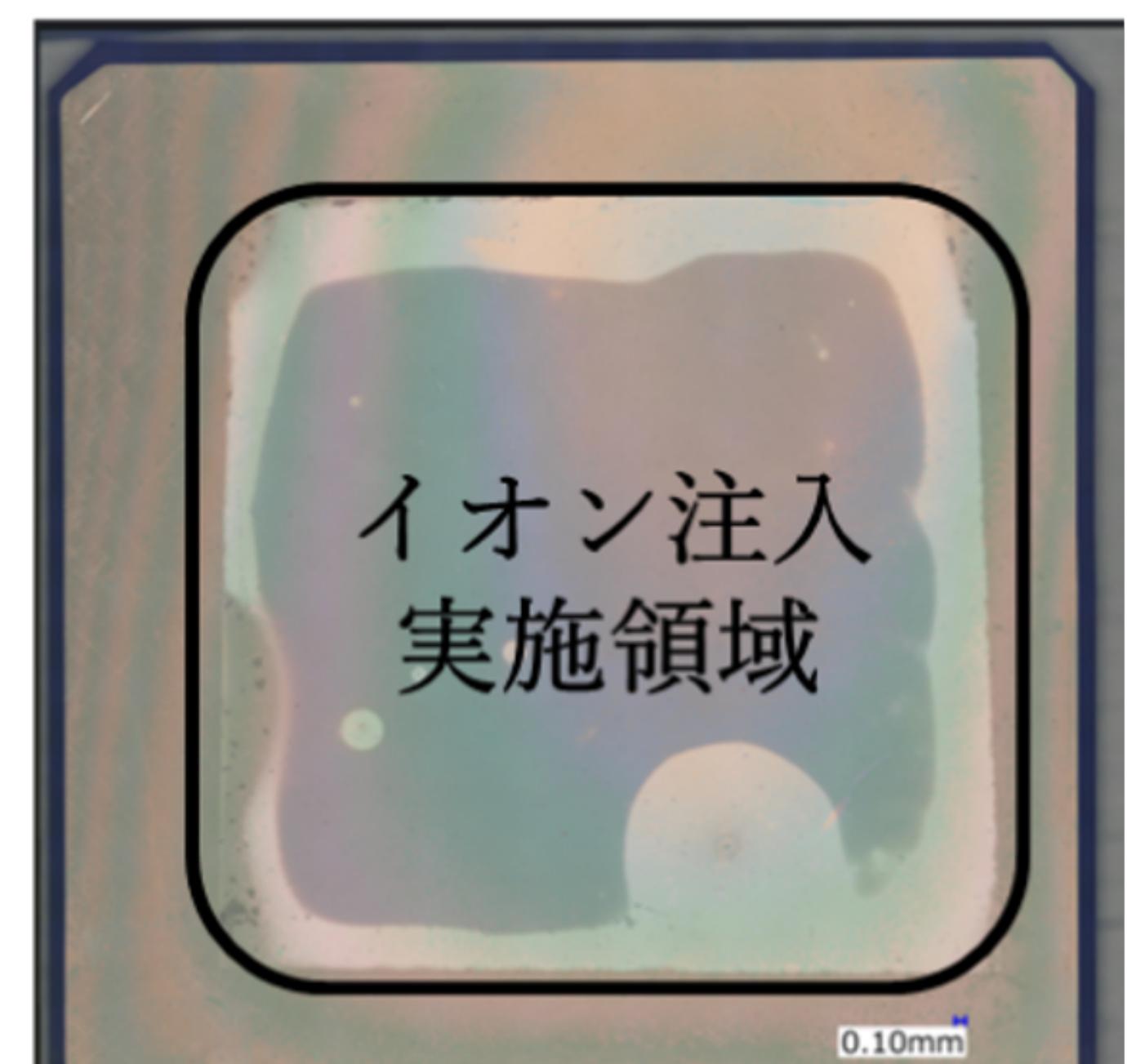


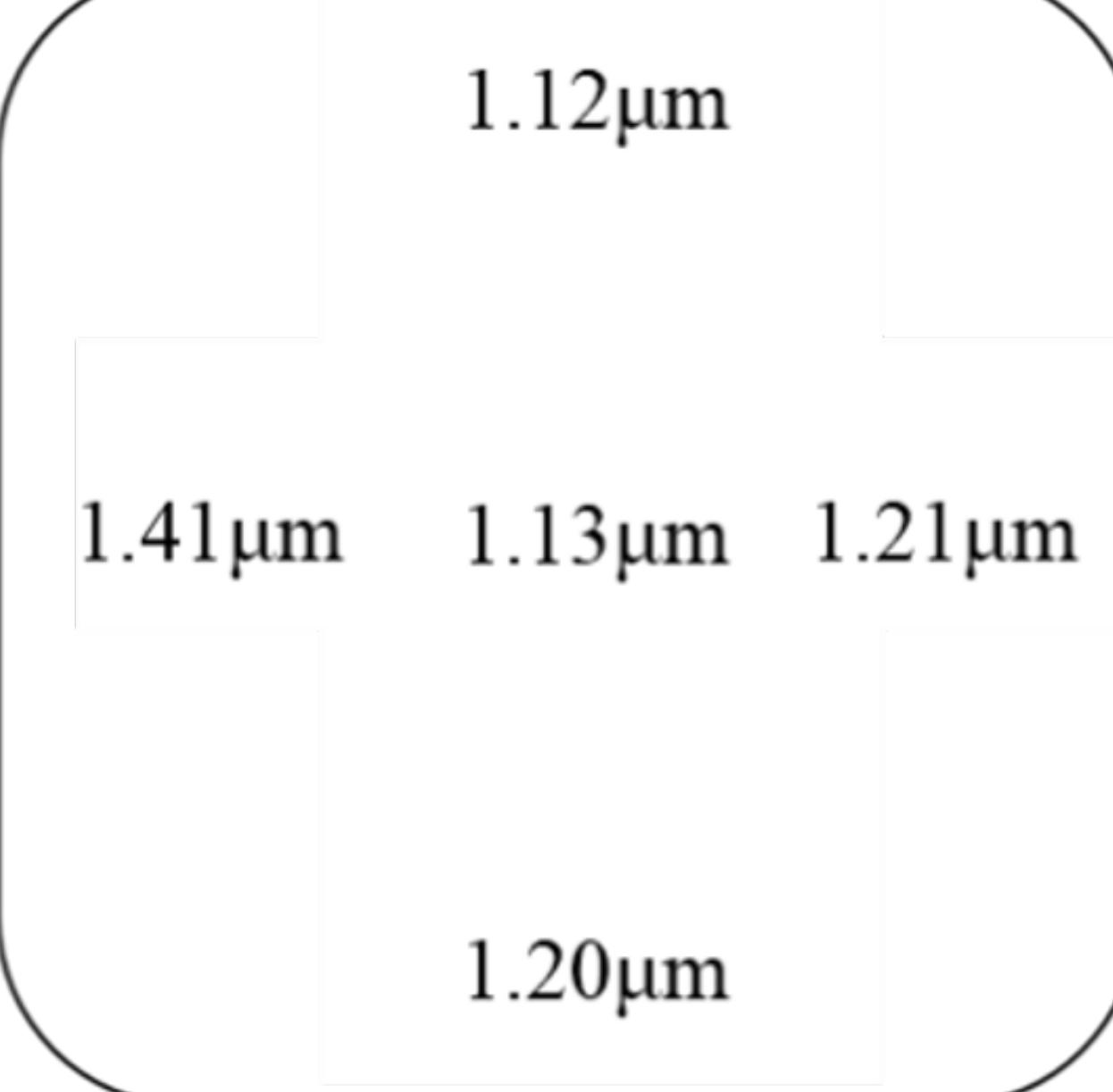
立命館大学発ベンチャー



PATENTIX



r-GeO₂薄膜の表面の外観写真



r-GeO₂薄膜の膜厚

「世界初」

r-GeO₂半導体における

ドナーのイオン注入に成功

～r-GeO₂パワーデバイスの製造技術の確立に大きく前進～